



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HX2785

对应国外型号
2SC2785

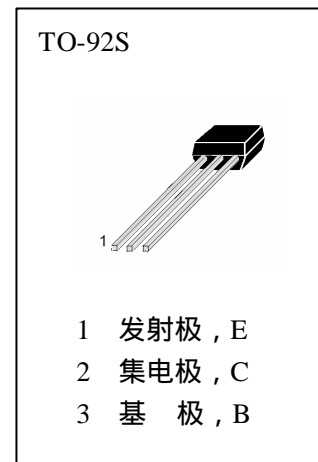
主要用途

开关、功放等。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg}	——贮存温度.....	-55~150
T_j	——结温.....	150
P_C	——集电极耗散功率.....	250mW
V_{CBO}	——集电极—基极电压.....	60V
V_{CEO}	——集电极—发射极电压.....	50V
V_{EBO}	——发射极—基极电压.....	5V
I_C	——集电极电流.....	100mA

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	50			V	$I_C=1mA, I_B=0$
V_{BE}	基极—发射极电压	0.55	0.62	0.65	V	$V_{CE}=6V, I_C=1mA$
I_{CB0}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{CB}=60V, I_E=0$
I_{EB0}	发射极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{EB}=5V, I_C=0$
$HFE1$	直流电流增益 1	50	185			$V_{CE}=6V, I_C=0.1mA$
$HFE2$	直流电流增益 2	110	200	600		$V_{CE}=6V, I_C=1mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		0.15	0.3	V	$I_C=100mA, I_B=10mA$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压		0.86	1	V	$I_C=100mA, I_B=10mA$
f_T	特征频率	150	250	450	MHz	$V_{CE}=6V, I_C=10mA$
C_{ob}	共基极输出电容		3	4	pF	$V_{CB}=6V, I_E=0, f=1MHz$

HFE2 分档及其标志

R	J	H	F	E	K
110-180	135-220	170-270	200-320	250-400	300-600